

NAR Labs

國家實驗研究院

水平爐管

注意事項

注意事項

- 01、欲操作使用爐管之研究生或同仁均需通過考核方可使用。
- 02、欲考核爐管者，須先考核過(1)Wet-Bench (2)N&K(3)Ellisopmeter。
- 03、使用爐管需確實填寫使用紀錄簿。
 - a) 開始執行Program後，便該立刻填寫，**填寫後才可離開**。
 - b) 填寫時務求字體工整，一定要留聯絡電話。
 - c) 若有沉積薄膜，一定要填寫厚度。
- 04、Nitride、TEOS、Oxide膜厚小於 100\AA 者，一律用橢圓測厚儀量測，大於 100\AA 者橢圓測厚儀或是N&K均可。Poly-Si與 α -Si則全部用N&K量測。
- 05、製程結束**前三十分鐘**就應至爐管區等待。
製程結束後至收完晶片開始執行Standby Program的時間**不可超過十五分鐘**。
- 06、即使收貨，也必須具備爐管使用資格。

注意事項

- 08、嚴禁進爐管之晶片：T8除外
- a) 未經 NDL class100 Wet-Bench 清洗 (超過4小時須再清洗)
 - b) 未去光阻
 - c) 破片或缺角
 - d) 含金屬(如經後段PECVD，CMP.....製程之晶片)
 - e) High-k 材料(金屬氧化物)
 - f) 非石英之玻璃基板
 - g) 含III-V族
 - h) 未經許可之特殊晶片 (表面有異物也算)
 - i) 未經旋乾之晶片
 - j) **Run過非NDL前段機台** (Run過交大奈米中心機台後，也不能再進爐管)
若有問題，請詢問工程師，若違規經查獲，必懲以最嚴厲之處分。
- 09、T8 H2-Sinter，晶片無需至Wet-Bench 清洗，也開放破片製程，此根爐管屬於後段爐管，有金屬污染，進過之後**不可再進其他前段機台**，否則會造成嚴重金屬污染。(吸筆獨立使用)。

注意事項

- 10、LPCVD在操作完之後，必須抽真空，確定**真空度到底壓**時(Pump2 沒有 Abort)，人才可離開。
- 11、學生出貨時間勿超過AM 8:00，以免影響操作員時間。
- 12、使用完請將檔片、控片放入正確的回收盒。
- 13、NDL上班時段(包含小夜08:00~22:00)如有空檔，學生可使用，但須先詢問代工製造與製程整合組技術員。
- 14、下列情況需先知會代工製造與製程整合組安排：
 - a)顧及他人權益，**厚度超過 $1\mu\text{m}$** ，**不得重複操作**(TEOS需等換新溶液)。
 - b)為有效利用資源，TEOS $5,000\text{\AA}$ 以上，且少於10片(因滿 $8\mu\text{m}$ 需更換)。